

TO-39 NPN SILICON PLANAR TRANSISTOR

General Transistor

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

DESCRIPTION	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector Emitter Voltage	V_{CEO}	80	V
Collector Base Voltage	V_{CBO}	140	V
Emitter Base Voltage	V_{EBO}	7.0	V
Collector Current Continuous	I_C	1.0	A
Power Dissipation at $T_a=25^\circ\text{C}$ Derate Above 25°C	P_D	0.8 4.6	W mW/ $^\circ\text{C}$
Power Dissipation at $T_c=25^\circ\text{C}$ Derate Above 25°C	P_D	5.0 28.6	W mW/ $^\circ\text{C}$
Operating and Storage Junction Temperature Range	T_j, T_{stg}	- 65 to +200	$^\circ\text{C}$

THERMAL RESISTANCE

Junction to Case	$R_{th(j-c)}$	16.5	$^\circ\text{C/W}$
Junction to Ambient in free air	$R_{th(j-a)}$	89.5	$^\circ\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$ unless specified otherwise)

DESCRIPTION	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN	TYP	MAX	UNIT
Collector Emitter Voltage	V_{CEO}	$I_C=1\text{mA}, I_B=0$	80			V
Collector Base Voltage	V_{CBO}	$I_C=100\mu\text{A}, I_E=0$	140			V
Emitter Base Voltage	V_{EBO}	$I_E=100\mu\text{A}, I_C=0$	7.0			V
Collector Cut Off Current	I_{CBO}	$V_{CB}=90\text{V}, I_E=0$			10	nA
		$V_{CB}=90\text{V}, I_E=0, T_a=150^\circ\text{C}$			10	μA
Emitter Cut Off Current	I_{EBO}	$V_{EB}=5\text{V}, I_C=0$			10	nA
			2N3019		2N3020	
DC Current Gain	$*h_{FE}$	$I_C=0.1\text{mA}, V_{CE}=10\text{V}$	>50		30 - 100	
		$I_C=10\text{mA}, V_{CE}=10\text{V}$	>90		40 - 120	
		$I_C=150\text{mA}, V_{CE}=10\text{V}$	100 - 300		40 - 120	
		$I_C=150\text{mA}, V_{CE}=10\text{V}, T_c=-55^\circ\text{C}$	>40		-	
		$I_C=500\text{mA}, V_{CE}=10\text{V}$	>50		30 - 100	
		$I_C=1\text{A}, V_{CE}=10\text{V}$	>15		>15	
			MIN	TYP	MAX	UNIT
Collector Emitter Saturation Voltage	$*V_{CE(sat)}$	$I_C=150\text{mA}, I_B=15\text{mA}$			0.2	V
		$I_C=500\text{mA}, I_B=50\text{mA}$			0.5	V
Base Emitter Saturation Voltage	$*V_{BE(sat)}$	$I_C=150\text{mA}, I_B=15\text{mA}$			1.1	V

*Pulse Test: Pulse Width $\leq 300\text{ms}$, Duty Cycle $\leq 1\%$

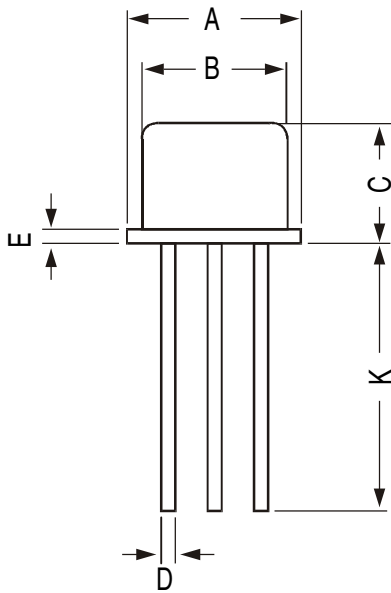
2N3019_20Rev_1 040406E

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$ unless specified otherwise)

SMALL SIGNAL CHARACTERISTICS

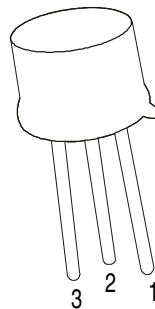
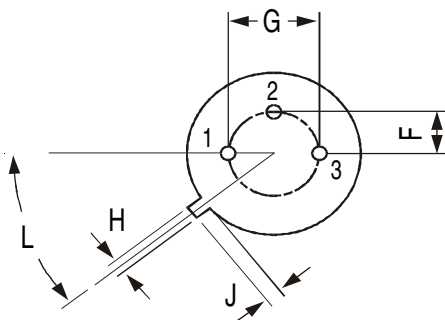
DESCRIPTION	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN	TYP	MAX	UNIT
Output Capacitance	C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$			12	pF
Input Capacitance	C_{ib}	$V_{EB}=0.5\text{V}, I_C=0, f=1\text{MHz}$			60	pF
Small Signal Current Gain	h_{fe}	$I_C=1\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}, f=1\text{KHz}$				
			2N3019	80		400
		2N3020	30		200	
Collector Rise Time Constant	$r_b'C_C$	$I_E=10\text{mA}, V_{CB}=10\text{V}, f=79.8\text{MHz}$			400	ps
Noise Figure	NF	$I_C=100\mu\text{A}, V_{CE}=10\text{V}, R_S=1\text{K}\Omega, f=1.0\text{KHz}$			4.0	dB

TO-39 Metal Can Package



All dimensions are in mm

DIM	MIN	MAX
A	8.50	9.39
B	7.74	8.50
C	6.09	6.60
D	0.40	0.53
E	—	0.88
F	2.41	2.66
G	4.82	5.33
H	0.71	0.86
J	0.73	1.02
K	12.70	—
L	42 DEG	48 DEG



PIN CONFIGURATION

1. EMITTER
2. BASE
3. COLLECTOR

DISCLAIMER NOTICE

Rectron Inc reserves the right to make changes without notice to any product specification herein, to make corrections, modifications, enhancements or other changes. Rectron Inc or anyone on its behalf assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies. Data sheet specifications and its information contained are intended to provide a product description only. "Typical" parameters which may be included on RECTRON data sheets and/ or specifications can and do vary in different applications and actual performance may vary over time. Rectron Inc does not assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit.

Rectron products are not designed, intended or authorized for use in medical, life-saving implant or other applications intended for life-sustaining or other related applications where a failure or malfunction of component or circuitry may directly or indirectly cause injury or threaten a life without expressed written approval of Rectron Inc. Customers using or selling Rectron components for use in such applications do so at their own risk and shall agree to fully indemnify Rectron Inc and its subsidiaries harmless against all claims, damages and expenditures.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9